(19)日本国特新庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-48460

(43)公開日 平成5年(1993)2月26日

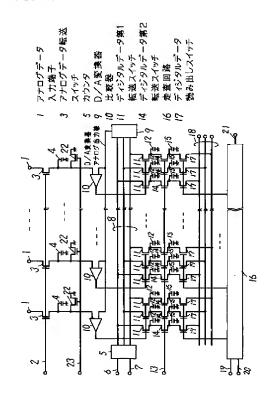
(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H 0 3 M 1/46		9065-5 J		
1/08	A	9065-5 J		
1/12	C	9065-5 J		
H 0 4 N 1/40	101 A	9068-5C		
	103 B	8943-5C		
			5	審査請求 未請求 請求項の数12(全 13 頁)
(21)出願番号	特顯平3-236059		(71)出願人	000005821
				松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)9月17日			大阪府門真市大字門真1006番地
			(72)発明者	山本 泰永
(31)優先権主張番号 特願平3-133985				大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
(32)優先日	平3(1991)6月5日			産業株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	山口 和文
				大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
				産業株式会社内
			(72)発明者	岡本 龍鎮
				大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
				産業株式会社内
			(74)代理人	弁理士 小鍜治 明 (外2名)

(54) 【発明の名称 】 A/D変換器とこれを用いたセンサ及び3次元集積回路

(57)【要約】

【目的】 並列入力される複数個のアナログ値を高速高 精度にディジタルに変換する。3次元集積回路やアレイ センサへの応用用途が有望である。

【構成】 複数個のアナログ値入力端子、アナログ値蓄 積部、複数個の比較器、単一のD/A変換器、ディジタ ルカウンタ、ディジタル値蓄積部、走査回路を備える。 アナログ値入力端子毎に加えた異なるアナログ値をアナ ログ値蓄積部に蓄えると共に、カウンタの動作に伴い漸 次増加するD/A変換器の参照出力値と共に比較器に入 力し、参照出力値の方が入力した個々のアナログ値を上 回る時のカウンタのデータを個別にディジタル値蓄積部 に蓄えた後に、ディジタル値蓄積部のデータを走査回路 により順次ディジタル値として読み出す。



【特許請求の範囲】

【請求項1】複数個のアナログデータ入力端子と、この複数のアナログデータ入力端子より入力される個々のアナログデータを蓄積する複数個のアナログ値蓄積部と、ディジタルカウンタと、このディジタルカウンタのディジタル出力をアナログ値に変換するD/A変換器と、このD/A変換器の出力値と前記アナログデータとを比較し、前記ディジタルカウンタがある時は前記D/A変換器の出力値が前記アナログデータを上回ったこともしくは、前記ディジタルカウンタがダウンカウンタである時は前記D/A変換器の出力値が前記アナログデータを下回ったことを判別する複数の比較手段と、この複数の比較手段による制御を受けて前記D/A変換器のディジタル値を記憶するディジタル値蓄積部とを備えたA/D変換器。

【請求項2】複数個のアナログデータ入力端子と、この 複数のアナログデータ入力端子より入力される個々のア ナログデータを蓄積するアナログ値蓄積部と、ディジタ ルカウンタと、このディジタルカウンタのディジタル出 力をアナログ値に変換するD/A変換器と、このD/A 変換器の出力値と前記アナログデータとを比較し、前記 ディジタルカウンタがアップカウンタである時は前記D /A変換器の出力値が前記アナログデータを上回ったこ ともしくは、前記ディジタルカウンタがダウンカウンタ である時は前記D/A変換器の出力値が前記アナログデ ータを下回ったことを判別する複数の比較手段と、この 複数の比較手段による制御を受けて前記D/A変換器の ディジタル値を記憶するディジタル値蓄積部とを備えた A/D変換器であって、さらに前記ディジタル値蓄積部 のデータの出力を順次読み出す走査回路を備えた請求項 1記載のA/D変換器。

【請求項3】複数の比較手段に基づいてD/A変換器のディジタル値を記憶し、記憶した前記ディジタル値をディジタル値蓄積部に伝達する第2の蓄積部と、この第2の蓄積部からディジタル値蓄積部へのディジタル値の伝達を制御する伝達スイッチ列とを備えた請求項2記載のA/D変換器。

【請求項4】アレイ状のセンシング素子の出力を請求項2記載のA/D変換器のアナログデータ入力端子に接続したディジタル信号出力のセンサ。

【請求項5】アレイ状をなしたセンシング素子である光電変換素子と、複数列の垂直電荷転送路と、電荷を電圧に変換してこれをアナログ出力とする増幅部とを備えた請求項4記載のセンサ。

【請求項6】アレイ状をなした複数の光電変換素子からの電圧値出力を各垂直出力線毎にフォロワ回路で増幅し、固定パターンノイズを除去する回路を列毎に備えたセンサ。

【請求項7】アレイ状をなした複数の光電変換素子から の電圧値出力をフォロワ回路で増幅し各垂直出力線に出 カし、結合容量の一方の端子をこの各垂直出力線に接続するとともに前記結合容量の他方の端子をスイッチの一方の端子に接続し、更に前記スイッチの他端を一定電位線に接続した構成をとるセンサであって、露光量情報を担うフォロワ出力が垂直出力線に現われている時に前記スイッチをオンにし、このスイッチがオフした後に増幅用トランジスタのゲート電位をリセットして前記垂直出力線にゲート電位がリセット電位にある前記増幅用トランジスタのフォロワ出力を出力することにより前記結合容量端子にゲート電位がリセット電位にある前記増幅用トランジスタのフォロワ出力と前記露光量情報を担ったフォロワ出力との差分の電圧を出力して、各垂直出力線毎に固定パターンノイズを除去する回路を備えたセンサ。

【請求項8】アレイ状をなした複数の光電変換素子からの電圧値出力をフォロワ回路で増幅し、列毎に固定パターンノイズを除去したアナログ出力を与える回路を備えた請求項4記載のセンサ。

【請求項9】アレイ状をなした複数の光電変換素子から の電圧値出力をフォロワ回路で増幅し各垂直出力線に出 力し、結合容量の一方の端子をこの各垂直出力線に接続 するとともに前記結合容量の他方の端子をスイッチの一 方の端子に接続し、更に前記スイッチの他端を一定電位 線に接続した構成をとるセンサであって、露光量情報を 担うフォロワ出力が垂直出力線に現われている時に前記 スイッチをオンにし、このスイッチがオフした後に増幅 用トランジスタのゲート電位をリセットして前記垂直出 力線にゲート電位がリセット電位にある前記増幅用トラ ンジスタのフォロワ出力を出力することにより前記結合 容量端子にゲート電位がリセット電位にある前記増幅用 トランジスタのフォロワ出力と前記露光量情報を担った フォロワ出力との差分の電圧を出力して、各垂直出力線 毎に固定パターンノイズを除去する回路を備えた請求項 4記載のセンサ。

【請求項10】A/D変換層の構成要素として請求項1 記載のA/D変換器を備え、他層からの複数個のアナログデータを前記A/D変換器の複数個のアナログデータ 入力端子に各々入力する構成の3次元集積回路。

【請求項11】アレイ状のセンシング素子からのアナログ値出力を並列にディジタル値に変換することを特徴とする請求項10記載の3次元集積回路。

【請求項12】露光量に応じて変化する複数個の光電変換デバイスの端子電圧をインピーダンス変換して各々のA/D変換器に伝達することを特徴とする請求項11記載の3次元集積回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は複数個のアナログ値をディジタル値に変換する装置及び前記変換装置を内蔵したセンサおよび3次元集積回路に関するものである。

[0002]

【従来の技術】アナログ値をディジタル値に変換する装置(以下A/D変換器と記す)としては積分型、逐次比較型、フラッシュ型等種々のものが存在するがいづれも基本的に1つのアナログ値を逐一ディジタル値に時系列的に変換するものであり、同時に複数個のアナログ値の変換を行うものではない。またA/D変換器を有するイメージセンサの場合、その形態は基本的に1つの入力端子を有する上記のようなA/D変換器をイメージセンサの各画素共通の1つのアナログ出力端子に接続したものであり、時系列的に出力されるアナログ信号値を逐一ディジタル値に変換するものにすぎない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来例のA/D変 換器においては以下のような課題が存在する。すなわち フラッシュ型のA/D変換器は高速変換できるが分解能 の上昇と共に回路が飛躍的に複雑化するし、積分型のA /D変換器は高精度であるが変換速度が小さい。複数個 のアナログ値データを有機的に信号処理する3次元集積 回路や、複数個のセンシング素子からアナログ値データ を得るアレイ状のセンサでは一般的に入力されてくるア ナログ値のデータを、種々のデータ処理を行うために、 A/D変換する必要がある。特にイメージセンサでは近 年、原稿読み取り速度の向上及び解像度の向上の観点か らますます高速の画像データの読み出しを要求されるよ うになってきているが、高速読み出しに伴い、アナログ 出力波形の立ち上がりに要する時間やスパイクノイズ等 の影響が大きくなり、従って信号値の精度を低下させる ことなくA/D変換することは困難になってくる。また 3次元集積回路においては必然的に内部に分布して存在 する複数個のアナログ値をディジタル値に高速に変換す る必要がある。この場合に A / D 変換処理すべきアナロ グ値の個数よりも極端に少ない個数の高速だが回路規模 の大きい1入力のA/D変換器を用いて上記の複数個の アナログ値について、マルチプレクスしながら高速に時 系列的にシリアルに順次変換することが考えられるが、 この場合は3次元集積回路内に分布する複数個のアナロ グ値から回路規模の大きいA/D変換器への多数の配線 の集中が生じて集積性の観点から望ましくはない。また アナログ値出力箇所からA/D変換器までの配線距離が 長くなることを意味しS/Nの観点からも望ましくなく 3次元集積回路の特長が活かされない。またフラッシュ 型A/D変換器を各アナログ値の個数と同等の個数だけ 備えるということも集積度の観点から望ましくはない、 等の課題が存在する。またA/D変換されるアナログ値 は当然固定パターンノイズが除去されているべきであ り、このための工夫も必要である。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に本発明のA/D変換器は、複数のアナログデータ入力 端子と、この複数のアナログデータ入力端子より入力さ れる個々のアナログデータを蓄積するアナログ値蓄積部 と、ディジタルカウンタと、このディジタルカウンタの ディジタル出力をアナログ値に変換するD/A変換器 と、このD/A変換器の出力値とアナログデータとを比 較し、ディジタルカウンタがアップカウンタである時は D/A変換器の出力値がアナログデータを上回ったこと もしくは、ディジタルカウンタがダウンカウンタである 時はD/A変換器の出力値がアナログデータを下回った ことを判別する複数の比較手段と、この複数の比較手段 による制御を受けてD/A変換器のディジタル値を記憶 するディジタル値蓄積部とを備えたA/D変換器であっ て、さらに前記ディジタル値蓄積部のデータの出力を順 次読み出す走査回路を備えたものである。また本発明の センサは複数個のセンシング素子のアナログ出力を本発 明のA/D変換器の複数のアナログデータ入力端子に入 力するものである。更に本発明の3次元集積回路は、本 発明のA/D変換器の各アナログデータ入力端子に3次 元集積回路内に分布する各アナログ値を入力するもので ある。またA/D変換されるアナログ値の固定パターン ノイズを除去するために上記のA/D変換器のアナログ データ入力端子毎に容量とスイッチからなるクランプ回 路を設ける。

[0005]

【作用】本発明は上記した構成によって、複数個のアナ ログデータ入力端子からのアナログ信号を各々個別に有 する蓄積部に蓄積しこれを個別の比較器のそれぞれ一方 の入力端子に伝達するとともに前記比較器の他方の入力 端子にはカウンタのディジタル値の増加に伴い漸次増加 または減少するD/A変換器の出力するアナログ値を参 照値として共通に入力する。前記参照値が前記比較器の 一方の入力端子に加えられたアナログ値を上回るまたは 下回るときに各比較器毎に前記アナログ信号値の大きさ に基くタイミングで前記各比較器出力がスイッチをオフ する。前記スイッチは各画素毎に有する前記カウンタの ディジタル値を各ビット毎に2値量として蓄積するディ ジタル値蓄積部に接続する。従って前記スイッチが比較 器の出力に基づいてオフになった際に各アナログデータ 入力端子毎のアナログ信号量に対応するディジタル値が 前記ディジタル値蓄積部に保持される。以上のアナログ 値からディジタル値への変換は各アナログデータ入力端 子について並列に行われ、この変換に要する時間は所定 のアナログ上限値に基づいて前記カウンタのカウント時 間によって決まる。上記アナログ値からディジタル値へ の変換が終了すれば前記のディジタル値蓄積部のデータ を順次ディジタル出力線からディジタル値として出力す る。各アナログデータ入力端子毎のA/D変換時間とデ ィジタル信号出力時間とをタイミングとして重なりを持 たせることにより、アナログ入力端子数の増加と共にA **/D変換時間を大きく取ることができる。また各アナロ**

グデータ入力端子毎にクランプ回路を設けたことにより、明時すなわち露光量を担う電圧出力が現われているタイミングで容量を介した一端を一定電圧値にクランプしておくことにより、暗時出力が現われるタイミングで前記クランプ回路の容量を介した出力端子に前記の明時出力および暗時出力の差分の電圧が現れるので固定パターンノイズが除去される。

[0006]

【実施例】以下本発明の実施例を図面を参照しながら説 明する。図1は本発明のA/D変換器の第1の実施例で ある。図 1 においては複数個のアナログデータ入力端子 1を有しておりこれらのデータは、アナログ値転送ゲー ト端子2によって駆動されるアナログデータ転送スイッ チ3を介してアナログ値蓄積部4に保持される。5はカ ウンタでありカウンタクロック入力端子6及びカウンタ クリア端子7によって制御される。8はカウンタ5から のバイナリ出力線である。なお図1では簡単のためカウ ンタ5を3ビットカウンタとしているが実際には何ビッ トカウンタでもよい。 D/A変換器9はバイナリ出力 端子8からのバイナリ出力をアナログ値に変換したデー タを複数個の比較器 10の一方の入力端子に与える。各 比較器10の他方の入力端子には前記アナログ値蓄積部 4に保持されたデータが入力される。比較の初期段階で はアナログ値蓄積部4のデータの方がD/A変換器9の アナログ出力線のデータよりも大きく、比較器 10の出 力はディジタルデータ第1転送スイッチ11をオン状態 にしてバイナリ出力線8のデータがそのままディジタル 値第1蓄積部12に伝達されている。カウンタ5がアッ プカウンタであればD/A変換器9のアナログ出力線の データ値がアナログ値蓄積部4のデータを上回った時点 で各アナログ並列入力データ毎にディジタルデータ第1 転送スイッチ11はオフ状態に転じ、以降ディジタルデ ータ第1蓄積部12のデータはディジタルデータ第1転 送スイッチ11がオフ状態に転じる直前のバイナリデー タを保持し続ける。カウンタ5がその最大値までカウン トアップを終えるとディジタル値転送ゲート端子13に より全てのディジタルデータ第1蓄積部12のデータは 一斉にディジタルデータ第2転送スイッチ14を介して ディジタル値第2蓄積部15に保持される。以下第2の ディジタル値蓄積部15に保持されたバイナリデータは 走査回路16の並列出力に基づいてディジタルデータ読 み出しスイッチ17を介してディジタル信号出力線18 に各アナログ並列入力データ毎にディジタル値として順 次読み出される。19は走査回路クロック入力端子、2 0は走査開始信号入力端子、21は走査回路キャリーパ ルス出力端子である。

【0007】この走査回路によるアナログ並列入力データ毎のディジタル信号出力線18への順次読み出しが行われている期間に並行して、次に入力されてくる列をなした1群のデータのアナログ値からディジタル値への変

換が前述のようにアナログ入力データ毎に並列に行われ る。アナログ値リセットスイッチ22はアナログ値蓄積 部4をリセットするためのスイッチでありリセットゲー ト端子23により制御される。本アナログ値リセットス イッチ22はアナログデータ入力端子1のインピーダン スが大きい場合に必要なものであり、出力インピーダン スの小さいバッファ等を介してアナログデータ入力端子 1にデータ入力が行われる場合には特に必要ではない。 走査回路クロック端子19及び走査開始信号入力端子2 0はカウンタクロック入力端子6及びカウンタクリア端 子7とは各々独立して設けているが、これは走査すべき アナログ並列入力データ数とA/D変換時のカウンタフ ルスケールが一般的に異なるため自明である。また図1 に示す A / D変換器を複数個直列接続してより多くのア ナログ並列入力データのA/D変換を行えるようにする ことも可能であり、これは前段のA/D変換器の走査回 路キャリー出力端子21を次段のA/D変換器の走査開 始信号入力端子20に順次受けるようにすれば容易に実 現できる。アナログ値蓄積部4、ディジタル値蓄積部1 2及び15は容量性素子として描写しているが、これは 更にインピーダンス変換素子をも含んだレジスタとして もよい。

【0008】特にディジタル値蓄積部12とディジタル データ第1転送スイッチ11はディジタルデータ第1転 送スイッチ11のゲート端子をイネーブル端子とするフ リップフロップに、ディジタル値蓄積部15とディジタ ルデータ第2転送スイッチ14はディジタル値転送ゲー ト端子13をイネーブル端子とするフリップフロップに してスタティックレジスタとしてもよい。D/A変換器 9は重み付け型やR-2R型等の一般的なD/A変換器 である。また本図に示すようなA/D変換器は積分型や カウンタ型と呼ばれるA/D変換器の範疇に入るもので あり、上記の説明ではカウントアップ型として説明を行 ったがカウントダウン型としてもよい。カウントダウン 型の場合は、比較の初期段階ではアナログ値蓄積部4の データの方がD/A変換器9のアナログ出力線のデータ よりも小さく、比較器10の出力はディジタルデータ第 1転送スイッチ11をオン状態にしてバイナリ出力線8 のデータがそのままディジタル値第1蓄積部12に伝達 されているが、D/A変換器9のアナログ出力線のデー タ値がアナログ値蓄積部4のデータを下回った時点で各 アナログ並列入力データ毎にディジタルデータ第1転送 スイッチ11はオフ状態に転じ、以降ディジタルデータ 第1蓄積部12のデータはディジタルデータ第1転送ス イッチ11がオフ状態に転じる直前のバイナリデータを 保持し続けることになる。

【0009】図1に示した構成1つでのみA/D変換器とする場合には走査開始信号入力端子20とカウンタクリア端子7とは共通結線が可能であり、更にカウンタフルスケールとアナログ並列入力データ数とが等しけれ

ば、走査回路クロック入力端子19とカウンタクロック 入力端子6とを共通結線して使用することも可能であ る。図2に図1のA/D変換器を駆動するためのタイミ ング図の1例を示す。図2ではディジタル化されたデー タの走査出力期間の方がA/D変換期間よりも長いとし ている。A/D変換期間とディジタル化データ出力期間 とが同時進行するために、アナログ並列入力データを与 え得るインターバルはこの両者の内の長い方の期間で決 ってくる。またA/D変換期間とディジタル化データ出 力期間とが同時進行するためにはディジタル値転送ゲー ト端子のHレベル期間がディジタル化データ出力期間が 開始するよりも早く終わっていなければならない。(図 2中のアナログ並列入力信号リセット信号とは図1のア ナログデータ入力端子1のデータ源をリセットする必要 がある場合のものであり、後述の本発明のセンサの実施 例の説明においてふれる。) ところでディジタル信号出 力線18に現われるデータはバイナリデータだからアナ ログ並列入力データ毎に順次高速読み出しが可能であ る。この読み出しが行われている一方で、アナログデー タからディジタルデータへの変換が各アナログ並列入力 データにおいて並列同時に行われている。仮にアナログ 並列入力データ数が2500であり、これをディジタル 信号出力線18から8ビットの分解能で5MHzで読み 出すとすれば、500μ秒の読み出し期間を必要とす る。カウンタ5が8ビットでそのフルスケールが255 であるとすれば、バイナリ出力線8とディジタル信号出 力線18は8本となり、前記500μ秒間に255クロ ックだけカウントすればよいから1クロック周期は約2 μ秒である。従って時間的に余裕のあるA/D変換が可 能であり、従ってD/A変換器9の内部素子として低ス ルーレートのオペアンプを使用できるのでグリッチの悪 影響もなく高精度化が可能である。また本実施例では3 ビットのA/D変換器としたが、任意のビット数のA/ D変換器に容易に拡張できることは明かである。

【0010】更に図2においてはアナログデータ転送スイッチ3、ディジタルデータ第1転送スイッチ11、ディジタルデータ第2転送スイッチ14、ディジタルデータ読み出しスイッチ17、リセットスイッチ22は各々NチャネルMOSFETとして描写及び説明を行ってきたが、NチャネルMOSFETではなくPチャネルMOSFET、並列CMOSスイッチ、またはJFETを使用してもよい。スイッチを駆動する際のゲート電位変化によるフィードスルー電位変動のデータ(とりわけアナログデータ)に対する影響を更に考慮する場合には並列CMOSスイッチが望ましい。

【0011】図3は図1におけるディジタル値転送ゲート端子13及びディジタルデータ第2転送スイッチ14とを省略したものであり、本発明のA/D変換器の第2の実施例である。図3中の素子で図1中に用いられている素子と等しい番号のものは機能的にも等しいので説明

を省略する。図3中24はディジタル値蓄積部である。 【0012】図3の駆動のためのタイミング図は図4の ようになる。即ちアナログ並列入力が与えられるインタ ーバルの内にまづA/D変換期間が現れ、引き続いてデ ィジタル化データ出力期間が現われる。つまりA/D変 換期間とディジタル化データ出力期間とが時間的に重な らないのでディジタルデータ第2転送スイッチを省略で きる。このようなA/D変換器の構成はA/D変換器の ディジタル出力のフルスケールが一度に並列入力される アナログデータ量と比較して極めて小さい場合に有効で ある。例えば並列入力数が5000で5MHェ読み出し に要する時間は 1 m秒であるが、ディジタル出力のフル スケールを7としカウンタクロックを100kHzとし たA/D変換期間は70μ秒程度となり1m秒に比べて 極めて小さく本A/D変換器が有効であることが分か る。

【0013】図3に示すA/D変換器もまた図1に示し たA/D変換器と同様に複数個直列接続してより多くの アナログ並列入力データのA/D変換を行えるようにす ることが可能である。アナログ値蓄積部4、ディジタル 値蓄積部24は容量性素子として描写しているが、これ は更にインピーダンス変換素子をも含んだレジスタとし てもよい。特にディジタル値蓄積部24とディジタルデ ータ転送スイッチ11はディジタルデータ転送スイッチ 11のゲート端子をイネーブル端子とするフリップフロ ップにしてスタティックレジスタとしてもよい。また本 A/D変換器も図1に示したA/D変換器と同様にカウ ントアップ型またはカウントダウン型のいづれとしても よい。本A/D変換器においてもA/D変換期間がディ ジタルデータ出力期間に比べて十分小さい場合には図1 のA/D変換器と同様に低スルーレートのオペアンプを D/A変換器9の内部素子として使用できるのでグリッ チの悪影響を低減できる。また本実施例も3ビットのA /D変換器としたが、任意のビット数のA/D変換器に 容易に拡張できることは明かである。更に図4において もアナログデータ転送スイッチ3、ディジタルデータ転 送スイッチ11、ディジタルデータ読み出しスイッチ1 7、リセットスイッチ22は各々NチャネルMOSFE Tとして描写及び説明を行ってきたが、NチャネルMO SFETではなくPチャネルMOSFET、並列CMO Sスイッチ、またはJFETを使用してもよい。スイッ チを駆動する際のゲート電位変化によるフィードスルー 電位変動のデータ(とりわけアナログデータ)に対する 影響を更に考慮する場合には並列СMOSスイッチが望

【0014】本発明のセンサの第1及び第2の実施例を 図5及び図6に示す。図5及び図6は各々図1及び図3 に示したA/D変換器のアレイ状のアナログデータ入力 端子の各々にセンシング素子25を付加したものであ る。図5、図6において各センシング素子25は検出す べき物理量を電圧までトランスデュースする部分と必要 に応じては検出部自体を初期化するリセットスイッチ及 びバッファ出力回路をも含むものである。(ここに述べ たリセットスイッチの動作タイミング図が図2及び図4 においてアナログ並列入力信号リセット信号として示し たものである。) 例えばセンシング素子25の中の検出 部での信号が電流としての出力形態であれば各センシン グ素子25は電流/電圧変換回路を含むものである。図 5に示すセンサは図1に示したA/D変換器のアナログ データ入力端子 1 に各センシング素子 2 5 の出力を並列 に導くものであり以下の動作は図2に示したタイミング 図の通りである。また図6に示すセンサも同様であり、 図3に示したA/D変換器のアナログデータ入力端子1 に各センシング素子25の出力を並列に導くものであり 以下の動作は図4に示したタイミング図の通りである。 このような構成のセンサではA/D変換器をも含めた1 チップ集積化デバイスもしくはハイブリッド集積化デバ イスとすることが可能であり、アナログデータの精度即 ちS/Nを劣化させることなくディジタル化できるこ と、前記デバイス外へディジタルデータとして出力信号 を引き出すことにより信号品質の低下を招くことがな い、等が特徴として挙げられる。

【0015】図5及び図6においては1次元アレイ状のセンサを説明したが、更に2次元アレイ状のセンサを図7を用いて説明する。図7中26はM行N列のエリアセンシング素子であり、25はM×N個のセンシング素子、27はM段の垂直走査回路、28はN個の列毎のセンシング素子出力端子であり、このセンシング素子出力端子であり、このセンシング素子出力端子28を各々図1または図3に示したA/D変換器のアナログデータ入力端子1に接続して且つA/D変換器の走査回路16を水平走査回路として駆動して2次元アレイ状センサを構成するものである。1段の垂直転送毎に1行のデータのA/D変換及びディジタル走査出力を得るように駆動を行う。

【0016】このような構成のセンサではA/D変換器をも含めた1チップ集積化デバイスもしくはハイブリッド集積化デバイスとすることが可能であり、アナログデータの精度即ちS/Nを劣化させることなくディジタル化できることと、前記デバイス外へディジタルデータとして出力信号を引き出すことにより信号品質の低下を招くことがない。

【0017】図8は図7のセンサをCCDセンサを基本とした場合のより具体的な第1の実施例のエリアセンサを示すものである。31は図1または図3に示したA/D変換器である。図8において、入射露光量に応じて各フォトダイオード39に蓄えられた電荷は垂直ブランキング期間毎に転送ゲート40の駆動によって垂直電荷転送路41に転送された後、垂直電荷転送路41をクロックパルス端子42を駆動することにより順次垂直方向に転送される。以後、各列の電荷は水平ブランキング期間

毎に1行毎に出力ゲート35の駆動によって浮遊拡散領域34に転送される。前記浮遊拡散領域34はバッファ33と共に浮遊拡散型増幅器として機能して浮遊拡散領域34の中の各電荷が有するアナログ値を同時に検出しこれをA/D変換器31のアナログデータ入力端子1に各々入力する。以下1行毎に各列のアナログデータが並列にA/D変換されてディジタル値としてディジタル信号出力線18にシリアルに出力される。図8中においてリセットゲート36はこれを駆動してリセット電位にある拡散領域38と前記浮遊拡散領域34とを結んでリセットを行うためのものである。37は拡散領域38の電位をリセット電位に保つためのラインである。1、18、19、20は各々図1または図3の中の同一番号のものと等しい。

【0018】尚、図8においてはインターライン転送型の電荷転送型撮像素子を基本とするA/D変換機能を有するセンサとして説明を行ったが、フレーム転送型やフレームインターライン転送型の電荷転送型撮像素子に対しても同様にA/D変換機能を有するセンサを実現できる。

【0019】ところで複数個のアナログデータ入力端子に与えられるアナログ値が各アナログデータ入力端子毎に異なるオフセット値を有する場合はこれが固定パターンノイズとなるので、これをA/D変換する前に除去する必要がある。従って各アナログデータ入力端子毎に容量とスイッチ等からなるクランプ回路を設ければ固定パターンノイズを除去できる。

【0020】従って図8のセンサにおいては、バッファ33をノイズを低減するために容量とスイッチからなるクランプ回路を基本構成とする相関2重サンプリング回路を含むものとしてもよい。即ち各水平ブランキング期間について各列の浮遊拡散領域34が一斉にリセット電位に保たれた直後に各列のクランプ回路の出力端子を一定電圧にクランプしておくことにより、前記各列の浮遊拡散領域34に一斉に露光量を担う出力が現われた際に前記各列のクランプ回路の出力端子には固定パターンノイズが除去された出力を得る。これにより各列毎にA/D変換するために好適なアナログ出力を得る。

【0021】図9(a)は図7のセンサを増幅型MOSセンサを基本とした場合のより具体的な第2の実施例のエリアセンサを示すものである。31は図1または図3に示したA/D変換器、47は定電流源を形成する素子、1、18、19、20は各々図1または図3の同一番号ものに等しいものである。図9(a)において、入射露光量に応じて各フォトダイオード44に蓄えられた電荷は垂直走査回路の働きにより選択された行について水平ブランキング期間毎に転送スイッチ43が一斉にオンし増幅用トランジスタ45のゲート電位として蓄えられる。この後転送スイッチ43はオフ状態にする。このとき増幅用トランジスタ45のドレインをハイレベルに

することによって、現在選択されている1行の増幅用ト ランジスタ45のゲート電位に基づいたフォロワ出力が 増幅用トランジスタ45の共通ソースである垂直出力線 46に現われる。或る1つの行の出力が垂直出力線46 に現われる場合、まずその行の露光量情報を担うフォロ ワ出力が現れ、続いてその行の増幅用トランジスタ45 のゲート電位がリセット用トランジスタ49により所定 のリセット値にリセットされた後の上記ゲート電位のフ ォロワ出力が現われる。本センサでは各画素毎に増幅用 トランジスタ45の閾値電圧に製造上の特性ばらつきが 生じ、これが増幅用トランジスタのゲート電位が一定値 に設定されてもフォロワ出力ばらつき即ち固定パターン ノイズとして現われる。従って上記の露光量情報を担う フォロワ出力とリセット後のフォロワ出力との差をとる ことが必要である。以下にこの方法を説明する。前記の 露光量情報を担うフォロワ出力が垂直出力線46に現わ れている時に結合容量50のバッファ52側の端子51 の電位をリセットするリセットスイッチ48をオンにす る。次に端子51の電位のリセットスイッチ48がオフ した後に増幅用トランジスタ45のゲート電位リセット 用トランジスタ49をオンにして垂直出力線46には今 度はリセット電位にあるゲート電位のフォロワ出力が現 われる。このとき端子51には前記リセット電位にある ゲート電位のフォロワ出力と前記露光量情報を担ったフ ォロワ出力との差分の電圧が現れ、この差分の出力電圧 をバッファ52を通してこれをA/D変換器31のアナ ログデータ入力端子1に各列毎に各々入力する。以上の ように差分をとることにより各増幅用トランジスタの特 性ばらつきに起因する固定パターンノイズを除去してい る。以下各列の差分のアナログ出力が並列にA/D変換 されてディジタル値としてディジタル信号出力線18に シリアルに出力される。以下、水平ブランキング期間毎 に1行づつ各列の差分のアナログ出力が並列に前記A/ D変換器31に入力されてはシリアルにディジタル値に 変換されて出力される。なお垂直信号線46と端子51 との間に増幅器を挿入してもよく、この増幅器が電圧増 幅部とそれに引き続くバッファ段からなる場合には出力 信号を大きくとることができる。この直後に前記の差分 電圧をとる回路があるので固定パターンノイズはやはり 除去される。

【0022】図9(a)のセンサで用いた固定パターンノイズを除去するための方法はA/D変換機能を有さないセンサとしても有効に働くので、そのような場合を図9(b)を用いて説明する。入射露光量に応じて各フォトダイオード44に蓄えられた電荷は垂直走査回路の働きにより選択された行について水平ブランキング期間毎に転送スイッチ43が一斉にオンし増幅用トランジスタ45のゲート電位として蓄えられる。この後転送スイッチ43はオフ状態にする。このとき露光量情報を担うフォロワ出力が垂直出力線46に現われているが、ここで

結合容量50の端子51の電位をリセットするリセット スイッチ48をオンにする。次に端子51の電位のリセ ットスイッチ48がオフした後に増幅用トランジスタ4 5のゲート電位リセット用トランジスタ49をオンにし て垂直出力線46には今度はリセット電位にあるゲート 電位のフォロワ出力が現われる。このとき端子51には 前記リセット電位にあるゲート電位のフォロワ出力と前 記露光量情報を担ったフォロワ出力との差分の電圧が現 れる。増幅器86を垂直信号線46と結合容量50との 間に挿入してもよい。増幅器86が電圧増幅機能を有す る場合は出力信号を大きくとることができるし、この場 合にも明時出力と暗時出力間の差分電圧をとる回路が設 けられているのでやはり固定パターンノイズを除去でき る。端子51に現われた明時出力と暗時出力との差分電 圧値を、水平走査回路の出力パルスにより順次スイッチ 84を介して共通水平出力線85に出力する。この水平 走査期間の露光による電荷は、転送スイッチ43がオフ 状態になっているので増幅用トランジスタ45のゲート とは分離されているので、後で読み出される列になるほ ど出力が大きくなるという列毎の露光時間の不均一性は 生じ得ない。

【0023】以上本発明のセンサによればA/D変換処理に好適な、固定パターンノイズを除去したアナログデータを得ることができ、センシング素子のアナログ量のディジタル化をセンサと同一チップ内もしくは近接した場所で、変換時間に長時間を要することなく行うことを可能とし、極めて高速に高品質のデータ収集が可能になる。本発明はハイブリッド構成においても大きな効果を有するのでA/D変換器に用いた半導体とは素材の異なるセンシング素子とも組合せ可能であり、その適用範囲は極めて広いということができる。

【0024】なお本発明は、センサへの応用例の説明においてはセンサとしては光情報を扱うイメージセンサを取り上げたが、光情報に限らずアレイ状をなした他の物理量を扱うセンシング素子においても適用可能である。

【0025】次に本発明の3次元集積回路の実施例を図面を参照しながら説明する。図10は本発明の実施例の3次元集積回路である。図10においては第1層、第2層、第3層からなる。第1層は光電変換層であり、図10では5行5列の光電変換単位素子からなる。第2層はA/D変換層であり、図10に示すように第1層の光電変換素子に対応して5行5列のA/D変換単位素子からなる。第3層は演算処理層である。3次元集積回路としてはさらに信号転送部、記憶部、電源部、駆動部等をも層に形成したものも存在するが、いづれも図10では光電変換部となっている多数のアナログデータの入力または発生部とA/D変換部とを一般的に有している。第2層のA/D変換層は多数個のアナログ値を同数個のディジタル値に変換する機能を有するが、そのA/D変換層をA/D変換単位素子部とA/D変換共通部とを合わ

せて図11に示す。図11においてはA/D変換単位素 子部を2行2列のアレイ状に並んだ形として描いてい る。本A/D変換層は既に説明した実施例である図1及 び図2のA/D変換器においてディジタル値出力のシリ アル出力方式を考慮しないものを2次元マトリックス状 に配列したものに相当する。即ち複数データのパラレル 入力、パラレル出力のA/D変換器となっている。図1 1においては図10の光電変換層からアナログ量を受け るべき複数個のアナログデータ入力端子61を有してお りこれらのデータは、アナログ値転送ゲート端子62に よって駆動されるアナログデータ転送スイッチ63を介 してアナログ値蓄積部64に保持される。65はカウン タでありカウンタクロック入力端子66及びカウンタク リア端子67によって制御される。68はカウンタ65 からのバイナリ出力線である。なお図10では簡単のた めカウンタ65を3ビットカウンタとしているが原理的 には求める階調性に応じて何ビットカウンタでもよい。 D/A変換器69はカウンタ65のバイナリ出力端子6 8からのバイナリ出力をアナログ値に変換したデータを 複数個の比較器70の一方の入力端子にD/A変換器ア ナログ出力線74を通して与える。各比較器70の他方 の入力端子には前記アナログ値蓄積部64に保持された データが入力される。比較の初期段階ではアナログ値蓄 積部64のデータの方がD/A変換器69のアナログ出 力線のデータよりも大きく、比較器70の出力はディジ タルデータ転送スイッチフ1をオン状態にしてバイナリ 出力線68のデータがバッファ増幅器72を経てディジ タル値出力端子組75に伝達されている。カウンタ65 がアップカウンタであればD/A変換器69のアナログ 出力線74の値がアナログ値蓄積部64のデータを上回 った時点で、即ち個々の光電変換単位素子毎に独立した タイミングで、各アナログ並列入力データ毎にディジタ ルデータ転送スイッチ71はオフ状態に転じ、以降ディ ジタル値蓄積部77およびバッファ増幅器72のデータ はディジタルデータ転送スイッチ71がオフ状態に転じ る直前のバイナリデータを保持し続ける。カウンタ65 がその最大値までカウントアップをし終えた後で、図示 はしないが、各ディジタル値出力端子組75のディジタ ル値出力をサンプリングする構成にすれば各アナログ並 列データ入力端子61に与えられたアナログ値に相当す るディジタル値が各入力端子毎に得られる。以下各画素 毎に得られたディジタル値は図10の演算処理層へ伝達 されて画像処理が行なわれる。アナログ値リセットスイ ッチ76はアナログ値蓄積部64をリセットするための スイッチでありリセットゲート端子73によって制御さ れる。本アナログ値リセットスイッチ76はアナログデ ータ入力端子61のインピーダンスが大きい場合に必要 なものであり、出力インピーダンスの小さいバッファ等 を介してアナログデータ入力端子61にデータ入力が行 われる場合には特に必要ではない。アナログ値蓄積部6

4、ディジタル値蓄積部77は容量性素子として描写しているが、これは更にインピーダンス変換素子をも含んだレジスタとしてもよい。

【0026】特にディジタル値蓄積部77とディジタル データ転送スイッチフ1はディジタルデータ転送スイッ チ71のゲート端子をイネーブル端子とするフリップフ ロップにしてスタティックレジスタとしてもよい。D/ A変換器69は重み付け型やR-2R型等の一般的なD /A変換器である。また本図に示すようなA/D変換器 は積分型やカウンタ型と呼ばれるA/D変換器の範疇に 入るものであり、上記の説明ではカウントアップ型とし て説明を行ったがカウントダウン型としてもよい。カウ ントダウン型の場合は、比較の初期段階ではアナログ値 蓄積部64のデータの方がD/A変換器69のアナログ 出力線74のデータよりも小さく、比較器70の出力は ディジタルデータ転送スイッチフ1をオン状態にしてバ イナリ出力線68のデータがそのままディジタル値蓄積 部77に伝達されているが、D/A変換器69のアナロ グ出力線74のデータ値がアナログ値蓄積部64のデー タを下回った時点で各アナログ並列入力データ毎にディ ジタルデータ転送スイッチ71はオフ状態に転じ、以降 ディジタル値蓄積部77のデータはディジタルデータ転 送スイッチフ1がオフ状態に転じる直前のバイナリデー タを保持し続けることになる。ところでディジタル値出 力端子組75に現われるデータはアナログ並列入力デー タ毎に一斉に読み出しが可能である。このことは3次元 集積回路のA/D変換器としては望ましい条件である。 また通常のフラッシュ型のA/D変換器よりも光電変換 単位素子当りのA/D変換素子数が小さい。これは1つ の光電変換単位素子当りについてのA/D変換単位素子 として必要な構成要素が比較器、ディジタルデータ蓄積 部、ディジタルデータ転送スイッチ、アナログデータ蓄 積部、アナログデータ転送スイッチ、リセットスイッ チ、バッファ増幅器等の個数も少なく且つ極めて簡単な 構造のデバイスからなっていることによる。本11図の ディジタル出力は簡単に図示するために3ビットとして いるがバイナリ出力線68、ディジタルデータ転送スイ ッチ71及びバッファ増幅器72の並列本数を8本にす れば容易に8ビットディジタル出力を実現できる。アナ ログデータからディジタルデータへの変換は各アナログ 並列入力データにおいて並列同時に行われている。カウ ンタ65のフルスケールが255であるとすれば、フレ 一ム期間内に255クロックだけカウントすればよく、 約500 μ秒なる短いフレーム期間であっても最高約5 00kHzという比較的低周波のクロックで駆動してよ く、従って時間的に余裕のあるA/D変換が可能であ り、D/A変換器69の内部素子として低スルーレート のオペアンプを使用できるのでグリッチの悪影響もなく 高精度化が可能である。従ってフラッシュ型のA/D変 換器ほど高速ではないが通常の光電変換素子のフレーム 周波数からすれば十分に高速、高精度のA/D変換ができ、きわめて高性能の3次元集積回路を実現できる。また本実施例では3ビットのA/D変換器としたが、任意のビット数のA/D変換器に容易に拡張できることは明かである。

【0027】更に図11においてはアナログデータ転送スイッチ63、ディジタルデータ転送スイッチ71、リセットスイッチ76は各々NチャネルMOSFETとして描写及び説明を行ってきたが、NチャネルMOSFETではなくPチャネルMOSFET、並列CMOSスイッチ、またはJFETを使用してもよい。スイッチを駆動する際のゲート電位変化によるフィードスルー電位変動のデータ(とりわけアナログデータ)に対する影響を更に考慮する場合には並列CMOSスイッチが望ましい。

【0028】図10の光電変換層内にある光電変換単位 素子としてはその端子間電圧が露光量に応じて変化する ものであればよく、その一方の端子電位を固定したとき 露光量情報を担う他方の端子の電位を図11中のアナロ グデータ入力端子61に与えればよい。例えばフォトダ イオードを用いてその端子間電位差を図11のアナログ データ入力端子61に与えればよい。図12は図11中 のアナログ値蓄積部に対する充電能力を向上するための 光電変換単位素子を示したものであり、78はフォトダ イオード等に代表される光電変換基本デバイスであり、 その一方の端子は固定電位端に、他方はインピーダンス 変換して光電変換単位素子としての電流駆動能力を向上 させるためのフォロワ回路構成をとる、インピーダンス 変換素子79のゲート端子に結線されている。80は光 電変換材料78の両端子間の電位差をリセットするため のリセットスイッチである。インピーダンス変換素子7 9のソース端子81に現われる電圧値を図11のアナロ グデータ入力端子61に与えて使用する。

【0029】以上、上記のような構成によれば、簡単な 回路構成と少ない素子数で高速高精度なA/D変換器を 単位光電変換素子毎に設けることが可能であり、高精度 ディジタル信号処理が可能な高集積度の3次元集積回路 を実現することができる。

【0030】なお本発明は、光電変換素子をアナログデータ入力源としたが、光情報に限らずアレイ状をなした光以外の他の物理量を扱うセンシングデバイスをアナログデータ入力源とした場合においても適用可能である。更に前記アナログデータの入力源は特にセンシングデバイスからの出力である必要もなく信号処理の過程で現われたなんらかのアナログ値であっても本質的に問題はなく本発明は適用されるものである。また必要であれば、図9(a)、(b)で説明したと同様にクランプ回路を設ければ固定パターンノイズの除去機能を有する3次元集積回路も実現することが可能である。

[0031]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば簡単 な回路構成によって、固定パターンノイズの除去機能を 有するセンサが可能になると共に、並列入力される複数 個のアナログ値をディジタル値に、A/D変換期間を節 約して、高精度に変換することが可能になるとことと、 変換されたディジタル値を高速走査して出力することに よって、高速高精度なパラレル入力/シリアル出力のA /D変換器を実現することができる。また上記のA/D 変換器に入力すべきアナログデータを与えるアレイ状の センシング素子を付加することにより、センシング素子 の各種の物理量情報量に基づくアナログ値をディジタル 値に各センシング素子毎に並列に変換することが可能と なり、前記ディジタル量を高速に読み出して高速、高S /Nのアレイ状センサを実現することができる。例えば 前記物理量として光を扱えば、本発明は画像入力装置と して極めて有用である。更に上記のA/D変換器を多入 力多出力構成とし、これにより多数のアナログ値を A/ D変換するA/D変換層を形成すれば、高精度で高集積 度である3次元集積回路を実現することができる。とり わけ本発明はアレイ状のセンシング素子を有する3次元 集積回路とりわけ画像処理用3次元集積回路用において 極めて好適である。

【0032】以上説明したように本発明の産業上の効果は極めて大である。

【図面の簡単な説明】

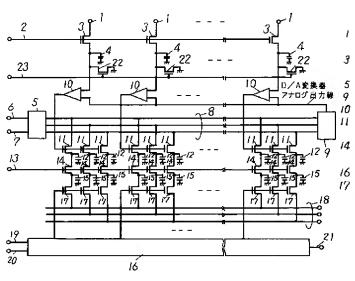
- 【図1】本発明のA/D変換器の第1の実施例における 回路図
- 【図2】図1のA/D変換器の駆動タイミング図
- 【図3】本発明のA/D変換器の第2の実施例における 回路図
- 【図4】図3のA/D変換器の駆動タイミング図
- 【図5】本発明のセンサの第1の実施例における回路図
- 【図6】本発明のセンサの第2の実施例における回路図
- 【図7】2次元アレイ状のセンサの構成図
- 【図8】本発明の第1の実施例の2次元アレイ状のセン サのブロック図
- 【図9】(a)は本発明の第2の実施例の2次元アレイ 状のセンサのブロック図(b)はA/D変換機能を備え ない2次元アレイ状のセンサのブロック図
- 【図10】本発明の実施例の3次元集積回路の機能説明 図
- 【図11】本発明の3次元集積回路に用いるA/D変換器の回路図
- 【図12】光電変換単位素子の回路図 【符号の説明】
- 1 アナログデータ入力端子
- 4 アナログ値蓄積部
- 5 カウンタ
- 9 D/A変換器
- 10 比較器

- 11 ディジタルデータ第1転送スイッチ
- 12、15、24 ディジタル値蓄積部
- 13 ディジタル値転送ゲート端子
- 14 ディジタルデータ第2転送スイッチ
- 16 走査回路
- 25 センシング素子
- 31 パラレルインーシリアルアウトA/D変換器
- 3 4 浮遊拡散領域
- 39 フォトダイオード
- 40 転送ゲート
- 41 垂直電荷転送路

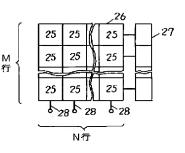
- 44 フォトダイオード
- 45 増幅用トランジスタ
- 46 垂直信号線
- 50 結合容量
- 5 1 差分信号出力端子
- 61 アナログデータ入力端子
- 63 アナログデータ転送スイッチ
- 65 カウンタ
- 69 D/A変換器
- 70 比較器
- 71 ディジタルデータ転送スイッチ

【図1】

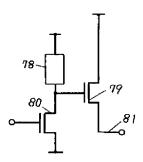
【図7】



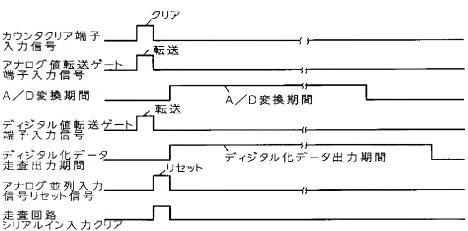
読み出しスイッチ

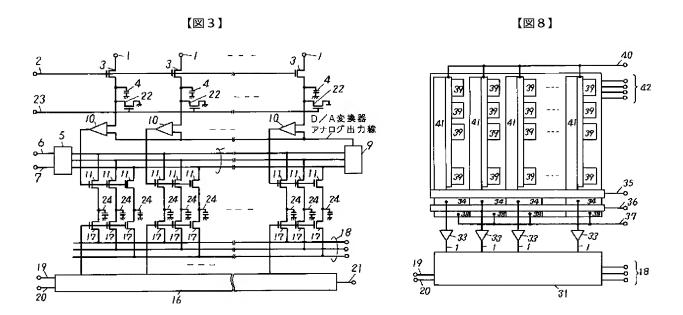


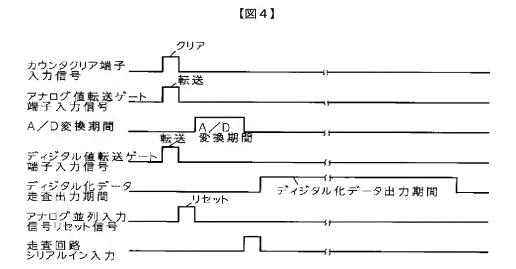
【図12】



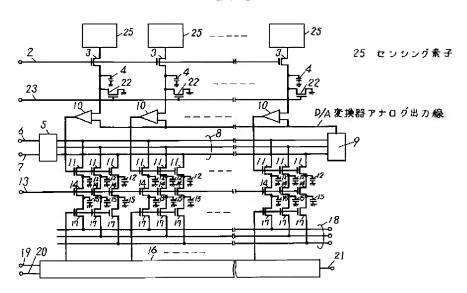
【図2】

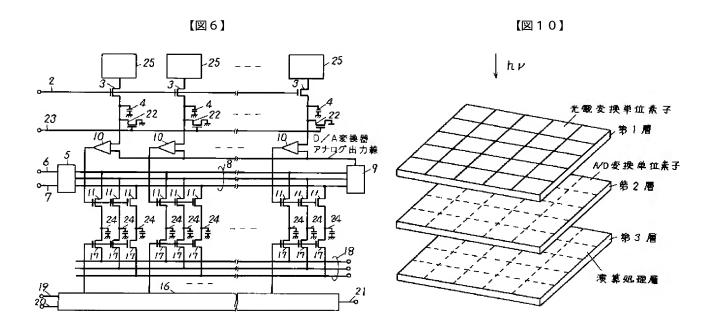




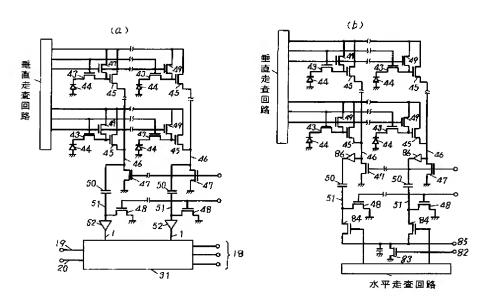


【図5】





【図9】



【図11】

